aa)

NOVEL CRYSTAL FORM OF PHTHALOCYANIN, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR USING THE SAME, PROCESS CARTRIDGE AND ELECTROPHOTOGRAPHIC APPARATUS

Publication number: JP2002235014

Publication date:

2002-08-23

Inventor:

AZUMA TAKASHI; TANAKA MASATO; HIRANO

HIDETOSHI; FUJII JUNJI; HAMA KAZUE

Applicant:

CANON KK

Classification:

- international:

C07D487/22; C09B47/08; C09B67/04; C09B67/12; C09B67/16; C09B67/50; G03G5/06; C07D487/00; C09B47/04; C09B67/00; G03G5/06; (IPC1-7): C09B67/50; C07D487/22; C09B47/08; C09B67/04;

C09B67/12; C09B67/16; G03G5/06

- european:

Application number: JP20010032495 20010208 Priority number(s): JP20010032495 20010208

Report a data error here

Abstract of JP2002235014

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a novel crystalline form of hydroxy gallium phthalocyanin with reduced unevenness in electrophotographic sensitivity by subjecting the conventional hydroxy gallium phthalocyanin having high unevenness in the photosensitivity caused by the difference in reaction conditions and a following treatment after the reaction, and to obtain a photoelectric photoreceptor having an extremely high photosensitivity to high wave length light beams, a process cartridge and an electrophotographic apparatus. SOLUTION: The hydroxy gallium phthalocyanin does not have a peak at 26.2 deg. Bragg angle (2&theta ± 0.2 deg.) but has peaks at the angles of 7.4 deg., 9.8 deg., 12.4 deg., 12.9 deg., 16.2 deg., 18.4 deg., 23.9 deg., 25.0 deg., 25.9 deg. and 28.1 deg. in the CuK&alpha characteristic X-ray diffraction and the half width value of 0.1 deg.<=W<=0.4 deg.. This invention further relates to a method the producing the hydroxy gallium phthalocyanin, the electrophotographic photoreceptor using the same, the process cartridge and the electrophotographic apparatus.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-235014 (P2002-235014A)

(43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I		テ-	-7](参考)
CO9B 67/50		C 0 9 B 67	7/50	Z	2H068
C 0 7 D 487/22		C 0 7 D 487	7/22		4 C 0 5 0
C 0 9 B 47/08		C 0 9 B 47	7/08		
67/04		67	7/04		
67/12			7/12		
51,12	審査請求	未請求 請求項	の数6 OL	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願2001-32495(P2001-32495)	(71)出顧人	000001007		
			キヤノン株式	会社	
(22)出願日	平成13年2月8日(2001.2.8)		東京都大田区	下丸子3丁目	30番2号
		(72)発明者	東 隆司		
		. 4	東京都大田区	下丸子3丁目3	30番2号 キヤ
			ノン株式会社	内	
		(72)発明者	田中 正人		
			東京都大田区	下丸子3丁目	30番2号 キヤ
			ノン株式会社	内	
		(74)代理人	100065385		
			弁理士 山下	穣平	
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フタロシアニンの新規な結晶型、該化合物結晶型の製造方法、該化合物を用いた電子写真感光 体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置

(57)【要約】

【課題】 反応条件や反応後処理の違いから、感度的に バラツキの多いヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶 を比較的簡単な処理により感度のバラツキの少ない新規 結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニン、その製造 方法を提供し、また長波長の光線に対して極めて高い光 感度を有する電子写真感光体、プロセスカートリッジ及 び電子写真装置を提供すること。

【解決手段】 $CuK\alpha$ 特性X線回折におけるブラッグ角($2\theta\pm0$. 2°)の26. 2° にピークを持たず、且つ7. 4° 、9. 8° 、12. 4° 、12. 9° 、16. 2° 、18. 4° 、23. 9° 、25. 0° 、25. 9° 及び28. 1° にピークを持ち、25. 9° の半値幅Wが0. 1° $\leq W \leq 0$. 4° であるヒドロキシガリウムフタロシアニン、該ヒドロキシガリウムフタロシアニンの製造方法、該ヒドロキシガリウムフタロシアニンを用いた電子写真感光体、該電子写真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 CuK α特性X線回折におけるブラッグ 角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ})$ の26.2° にピークを持たず、 且つ7.4°、9.8°、12.4°、12.9°、1 6. 2°, 18. 4°, 23. 9°, 25. 0°, 2 5. 9°及び28. 1°にピークを持ち、25. 9°の 半値幅₩が0.1°≦₩≦0.4°であることを特徴と するヒドロキシガリウムフタロシアニン。

【請求項2】 ヒドロキシガリウムフタロシアニンの製 造方法において、CuKα特性X線回折におけるブラッ 10 グ角($2\theta \pm 0$. 2°)の7. 4° 、9. 8° 、12. 4°, 12.9°, 16.2°, 18.4°, 23.9 、25.0°、25.9°、26.2°及び28.1 ゜ にピークを持つヒドロキシガリウムフタロシアニンを アミド系溶剤又は水ーアミド系混合溶剤で溶媒処理し T、 $CuK\alpha$ 特性X線回折におけるブラッグ角($2\theta \pm$ 0.2°)の26.2°にピークを持たず、且つ7.4 ° 、 9. 8° 、 12. 4° 、 12. 9° 、 16. 2° 、 18.4°、23.9°、25.0°、25.9°及び 28.1° にピークを持ち、25.9° の半値幅Wが 0.1°≦₩≦0.4°であるヒドロキシガリウムフタ ロシアニンを得る工程を有することを特徴とするヒドロ キシガリウムフタロシアニンの製造方法。

【請求項3】 支持体上に少なくとも感光層を有する電 子写真感光体において、該感光層に請求項1に記載のヒ ドロキシガリウムフタロシアニンを含有することを特徴 とする電子写真感光体。

【請求項4】 前記感光層が電荷発生層と電荷輸送層と の積層体で、該電荷発生層に前記ヒドロキシガリウムフ タロシアニンを含有する請求項3に記載の電子写真感光 30 体。

【請求項5】 請求項3又は4に記載の電子写真感光体 を、該電子写真感光体を帯電させる帯電手段、静電潜像 の形成された電子写真感光体をトナーで現像する現像手 段、及び転写工程後の電子写真感光体上に残余するトナ ーを回収するクリーニング手段からなる群より選ばれた 少なくとも1つの手段と共に一体に支持し、電子写真装 置本体に着脱自在であることを特徴とするプロセスカー トリッジ。

請求項3又は4に記載の電子写真感光 【請求項6】 体、該電子写真感光体を帯電させる帯電手段、帯電した 電子写真感光体に対し露光を行い静電潜像を形成する露 光手段、静電潜像の形成された電子写真感光体にトナー で現像する現像手段、及び電子写真感光体上のトナー像 を転写材上に転写する転写手段を備えることを特徴とす る電子写真装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ヒドロキシガリウ ムフタロシアニン新規結晶型、該ヒドロキシガリウムフ

タロシアニンの製造方法、該ヒドロキシガリウムフタロ シアニンを用いた電子写真感光体、該電子写真感光体を 有するプロセスカートリッジ及び電子写真装置に関す

2

[0002]

【従来の技術】フタロシアニンは、染料や顔料等の着色 用途の他、電子写真感光体、太陽電池、センサー、消臭 ・抗菌、触媒、癌の光化学治療、光記録材料又は光化学 材料等としての検討、応用化が数多くなされている。特 に近年、電子写真技術を用いた端末用プリンター、特に 光源としてレーザー光を用いるレーザービームプリンタ 一の需要の高まりから、電子写真感光体材料にフタロシ アニンを用いることが多くなってきている。これはレー ザービームプリンターの光源としては、コストや装置の 大きさ等の点から790~820nmの波長半導体レー ザーが用いられることから、この長波長のレーザー光に 十分な感度を有し、比較的安価で構造的に強く、更に光 学的安定な材料を電子写真感光体材料としてフタロシア ニンが選ばれるためである。

【0003】また、フタロシアニンの電子写真感光体と しての具体的な検討例としては、新規フタロシニン材料 の合成、あるいは結晶系制御を行うことで、吸収波長領 域、結晶の電子状態を制御する等の検討が行われてい る。

【0004】その結果、最適な電子写真感光体材料例と して、アルミニウムクロロフタロシアニン、クロロイン ジウムフタロシアニン、オキシバナジルフタロシアニ ン、ヒドロキシガリウムフタロシアニン、クロロガリウ ムフタロシアニン、マグネシウムフタロシアニン及びオ キシチタニウムフタロシアニン等の金属フタロシアニン あるいは無金属フタロシアニン等についての研究が挙げ られる。

【0005】また更に、結晶形の例としては、無金属フ タロシアニンでのlpha型、eta型、 γ 型、 δ 型、 ϵ 型、f x型 及びau型等があり、銅フタロシアニンではlpha型、eta型、 γ 型、 ϵ 型及び \mathbf{x} 型等が一般に挙げられる。

【0006】本発明者らは、フタロシアニンを用いた最 適な電子写真感光体材料を鋭意検討した結果、これら数 多くの材料の中から、ヒドロキシガリウムフタロシアニ 40 ン、特に C u K α特性 X 線回折におけるブラッグ角 (2 $\theta \pm 0.~2$ °) $\varpi 7.~4$ °, 9.~8°, 1.2.~4°, 12. 9°, 16. 2°, 18. 4°, 23. 9°, 2 5.0°、25.9°、26.2°及び28.1°にピ ークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニンが、充 分な感度を始め優れた電子写真特性を持つことに着目 し、上記ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を用い て電子写真感光体を作製した。しかしながら、このヒド ロキシガリウムフタロシアニン結晶は、反応条件、ある いは反応後の処理条件の微妙な差異が、出来上がった電 50 子写真感光体の感度がバラッキ、十分満足できる電子写

真感光体は得られなかった。

【0007】CuKα特性X線回折におけるブラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ}) 07.4^{\circ}, 9.8^{\circ}, 12.4$, 12. 9°, 16. 2°, 18. 4°, 23. 9 、25、0°、25、9°、26、2°及び28、1 * にピークを有するヒドロキシガリウムフタロシアニン に関しては、特開平5-263007号公報や特開平6 -93203号公報等に数種類の結晶形が開示されてい る。本願発明者は、上記ヒドロキシガリウムフタロシア ニンに関して鋭意検討を行った結果、ヒドロキシガリウ ムフタロシアニンの反応条件、あるいは反応後処理の微 妙な違いによってCuΚα特性X線回折におけるブラッ グ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ})$ が25.9° のピークの半値 幅、26.2°の回折線の有無が異なり、またこの差異 が感度のバラツキと関係していることを見出した。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、反応 条件や反応後処理の違いから、感度的にバラツキの多い 上記ヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を比較的簡 単な処理により感度のバラツキの少ない新規結晶形のヒ 20 ドロキシガリウムフタロシアニン、該ヒドロキシガリウ ムフタロシアニンの製造方法を提供することにある。

[0009]本発明の別の目的は、長波長の光線に対し て極めて高い光感度を有する電子写真感光体、該電子写 真感光体を有するプロセスカートリッジ及び電子写真装 置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明に従って、CuK α 特性X線回折におけるブラッグ角($2\theta \pm 0.2^{\circ}$) の26、2° にピークを持たず、且つ7、4°、9、8 30 , 12. 4°, 12. 9°, 16. 2°, 18. 4 、23.9°、25.0°、25.9°及び28.1 * にピークを持ち、25.9°の半値幅Wが0.1°≦ ₩≦0.4°であることを特徴とするヒドロキシガリウ ムフタロシアニンが提供される。

【0011】また、本発明に従って、ヒドロキシガリウ ムフタロシアニンの製造方法において、CuKα特性X 線回折におけるブラッグ角($2\theta \pm 0$. 2°)の7. 4*, 9.8*, 12.4*, 12.9*, 16.2*, 18.4°, 23.9°, 25.0°, 25.9°, 2 6. 2° 及び28. 1° にピークを持つヒドロキシガリ ウムフタロシアニンをアミド系溶剤又は水ーアミド系混 合溶剤で溶媒処理して、CuKa特性X線回折における ブラッグ角 $(2\theta \pm 0.2^{\circ})$ の26.2° にピークを 持たず、且つ7.4°、9.8°、12.4°、12. 9°, 16. 2°, 18. 4°, 23. 9°, 25. 0 、25.9°及び28.1°にピークを持ち、25. 9°の半値幅Wが0.1°≤W≤0.4°であるヒドロ キシガリウムフタロシアニンを得る工程を有することを 特徴とするヒドロキシガリウムフタロシアニンの製造方 50 ダイバージェンススリット:0.5deg.

法が提供される。

【0012】更に、本発明に従って、支持体上に少なく とも感光層を有する電子写真感光体において、該感光層 に上記ヒドロキシガリウムフタロシアニンを含有すると とを特徴とする電子写真感光体、該電子写真感光体を有 するプロセスカートリッジ及び電子写真装置が提供され

4

[0013]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を詳 細に説明する。

【0014】本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニ ンは、図1に示すようにCuKα特性X線回折における ブラッグ角($2\theta \pm 0$. 2°)の26. 2° にピークを 持たず、且つ7.4°、9.8°、12.4°、12. 9°, 16. 2°, 18. 4°, 23. 9°, 25. 0 、25.9°及び28.1°にピークを有し、25. 9°の半値幅Wが0.1°≦W≦0.4°であることを 特徴とするもので、以下の構造を有するものである。

[0015]

【化1】

【0016】 とのヒドロキシガリウムフタロシアニンを 電子写真感光体の電荷発生材料として使用することによ って、長波長の光に対して高い感度の電子写真感光体が 得られる。本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニン の結晶型のX線回折の測定はCuKα線を用い、次の条 件で行ったものである。

40 【0017】使用測定機:マック・サイエンス社製、全 自動X線回折装置MXP18

X線管球: Cu 管電圧:50KV 管電流:300mA

スキャン方法: 2 θ / θ スキャン スキャン速度:2deg./min サンプリング間隔:0.020deg. スタート角度(2θ):5deg. ストップ角度(2θ):40deg.

スキャッタリングスリット:0.5deg. レシービングスリット: 0.3deg. 湾曲モノクロメーター使用

【0018】ととで、半値幅について説明する。図2に 示すように、X線回折ピークプロファイルのバックグラ ウンドAを引き、このバックグラウンドAと平行でピー クの頂点Xと接している接線Bを引く。そして頂点Xか ら垂線Cを引き、垂線CとバックグラウンドAとの接点 Yと頂点Xとの垂線C上の中点Zを通り且つバックグラ ウンドAと平行である中線Dを引く。中線DとX線回折 10 プロファイルとの接点の幅▼を半値幅と定義する。ま た、ピークにショルダーが観測される場合の半値幅W は、図3に示した様に測定するものと定義する。

【0019】一般に、X線の回折線の幅は分子構造の揺 らぎ、また半値幅がある程度より大きい場合、特に図3 の様にショルダービークを持つ場合は2つ以上の回折線 が存在することを意味する。すなわち、下記数式(1) ... (1) $\lambda = 2 d \cdot s i n \theta$

(式中、 λ は使用したX線の波長、dは格子面間隔、hetaはブラッグ角を示す)で表されるブラック角θは、格子 20 面間隔に揺らぎがないものであれば、幅のない1本線と なる。しかしながら、室温では結晶格子の秩序に熱的な 揺らぎが存在し、このことからある程度回折線に幅が存 在する。例えば、結晶格子が5×10-3nm熱的に揺ら いだとするならば、25.9°のピークは前後に約0. 2°程度の幅を持つとととなる。従って、回折線の半値 幅Wは、この2つの要素を踏まえたものでなければなら ず、このため本発明では半値幅Wの設定を0.1°≦W ≦0.4° とした。

[0020] 本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニ ン結晶は、光導電体としての機能に優れ、電子写真感光 体以外にも、太陽電池、センサー及びスイッチング素子 等に適用することができる。

【0021】本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニ ンは、以下の方法により製造される。

【0022】クロロガリウムフタロシアニン等のハロゲ ン化ガリウムフタロシアニンをアシッドペースティング 法により処理してペースト状の含水ヒドロキシガリウム フタロシアニンを得る。次に、との含水ヒドロキシガリ ウムフタロシアニンを乾燥して低結晶性のヒドロキシガ リウムフタロシアニンとする。得られた低結晶のヒドロ キシガリウムフタロシアニンを、アセトアミド、N, N -ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミ ド、N-メチルホルムアミド、N-メチルアセトアミ ド、N-メチルプロピオアミド又はホルムアミド等のア ミド系溶剤を分散剤として用いてミリング処理を行うと とにより本発明の結晶形前駆体であり、C u K α特性X 線回折におけるブラッグ角(2 $\, heta\pm0$.2 $^\circ$)の7.4 °, 9, 8°, 12, 4°, 12, 9°, 16, 2°, 18.4°、23.9°、25.0°、25.9°、2 50 【0029】単一層からなる感光層を形成する場合、本

6.2°及び28.1°にピークを持つヒドロキシガリ ウムフタロシアニンが得られる。更に、この前駆体を、 アセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N -ジメチルアセトアミド、N-メチルホルムアミド、N - メチルアセトアミド、N - メチルプロピオアミド又は ホルムアミド等の加熱アミド系溶剤、あるいは熱水-熱 アミド系混合溶媒で数回室温、あるいは加熱溶媒処理を 行うことで本発明に示される結晶系のヒドロキシガリウ ムフタロシアニンが得られる。また、ハロゲン化ガリウ ムフタロシアニンの合成は、特開平6-93203号公 報に記載されている様に色々な方法がある。

6

【0023】ここで行うミリング処理とは、例えば、ガ ラスビーズ、スチールビーズ又はアルミナボール等の分 散メディアと共に、サンドミル又はボールミル等のミリ ング装置を用いて行う処理である。ミリング処理時間 は、使用するミリング装置により異なるため、一概には 言えないが4~24時間程度が好ましい。あまり長すぎ ても本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニンはでき ない。一番好ましい方法は、1~3時間おきにサンプル をとりブラッグ角を確認することである。ミリング処理 で用いる分散剤の量は、質量基準で低結晶ヒドロキシガ リウムフタロシアニンの10~50倍が好ましい。

【0024】また、ととに示した溶媒処理とはヒドロキ シガリウムフタロシアニンを室温あるいは加熱状態で1 時間以上攪拌、あるいはソックスレー抽出器を用いて加 熱溶媒で30分間以上の洗浄を行うことを意味する。

【0025】次に、本発明のヒドロキシガリウムフタロ シアニン結晶を電子写真感光体における電荷発生材料と して適用する場合を説明する。

【0026】本発明に係る電子写真感光体の構造例を図 10に示す。本発明における電子写真感光体の層構成 は、支持体上に電荷発生材料と電荷輸送材料を同時に含 有する単一層からなる感光層を有する層構成と、支持体 上に電荷発生材料を含有する電荷発生層と電荷輸送材料 を含有する電荷輸送層を積層する感光層を有する層構成 がある。なお、電荷発生層と電荷輸送層の積層関係は逆 であってもよいが、電子写真特性的には電荷発生層、電 荷輸送層の順に積層する方が好ましい。

[0027] 支持体としては、導電性を有するものであ ればよく、アルミニウムやステンレス等の金属あるいは 導電層を設けた金属、プラスチック及び紙等が挙げら れ、形状としては円筒状やフィルム状等が挙げられる。 【0028】支持体と感光層の間には、バリヤー機能と 接着機能を持つ下引き層を設けることもできる。下引き 層の材料としては、ポリビニルアルコール、ポリエチレ ンオキシド、エチルセルロース、メチルセルロース、カ ゼイン、ポリアミド、にかわ及びゼラチン等が挙げられ る。これらは、過当な溶剤に溶解して支持体上に塗布さ れる。その膜厚は0.2~3.0μmが好ましい。

発明のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶の電荷発生材料と電荷輸送材料を過当なバインダー樹脂溶液中に混合して、この混合液を支持体上に塗布乾燥して形成される

7

【0030】積層構造からなる感光層を形成する場合、電荷発生層は、本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を過当なバインダー樹脂溶液と共に分散し、この分散液を塗布乾燥して形成する方法が挙げられるが、蒸着することによって層形成することもできる。

【0031】電荷輸送層は、主として電荷輸送材料とバ 10 インダー樹脂とを溶剤中に溶解させた塗工液を塗布乾燥して形成する。電荷輸送材料としては、各種のトリアリールアミン系化合物、ヒドラゾン系化合物、スチルベン系化合物、ピラゾリン系化合物、オキサゾール系化合物、チアゾール系化合物及びトリアリルメタン系化合物等が挙げられる。

【0032】各層に用いるバインダー樹脂としては、例えば、ポリエステル、アクリル樹脂、ポリビニルカルバゾール、フェノキシ樹脂、ポリカーボネート、ポリビニルブチラール、ポリスチレン、ポリビニルアセテート、ポリサルホン、ポリアリレート、塩化ビニリデン、アクリロニトリル共重合体及びポリビニルベンザール等の樹脂が挙げられる。

【0033】感光層の塗布方法としては、ディッピング法、スプレーコーティング法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ブレードコーティング法又はビームコーティング法等の塗布方法を用いることができる。

[0034] 感光層が単一層の場合、膜厚は $5\sim40~\mu$ mが好ましく、特には $10\sim30~\mu$ m好ましい。積層構造の場合、電荷発生層の膜厚は $0.01\sim10~\mu$ mが好ましく、特には $0.05\sim5~\mu$ mが好ましく、電荷輸送層の膜厚は $5\sim40~\mu$ mが好ましく、特には $10\sim30~\mu$ mが好ましい。

[0035] 電荷発生材料の含有量は、電荷発生層に対して20~80質量%、更には30~70質量%が好ましい。電荷輸送材料の含有量は、電荷輸送層に対して20~80質量%、更には30~70質量%が好ましい。

【0036】感光層が単一層の場合、電荷発生材料の含有量は、感光層に対して3~30質量%が好ましい。電 40荷輸送層の含有量は、感光層に対して30~70質量%が好ましい。

[0037] 本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を電荷発生材料として用いる場合、その目的に応じて他の電荷発生材料と混合して用いることもできる。 との場合、ヒドロキシガリウムフタロシアニンの割合は、全電荷発生材料に対して50質量%以上が好ましい。

【0038】感光層上には、必要に応じて保護層を設けてもよい。保護層は、ポリビニルブチラール、ポリエス

テル、ポリカーボネート (ポリカーボネート Zや変性ポリカーボネート等)、ポリアミド、ポリイミド、ポリアリレート、ポリウレタン、スチレンーブタジエンコポリマー、スチレンーアクリル酸コポリマー又はスチレンーアクリロニトリルコポリマー等の樹脂を適当な有機溶剤によって溶解し、感光層の上に塗布、乾燥して形成できる。保護層の膜厚は0.05~20μmが好ましい。また、保護層中に導電性粒子や紫外線吸収剤等を含ませてもよい。導電性粒子としては、例えば酸化錫粒子等の金属酸化物が好ましい。

8

【0039】図11に本発明の電子写真感光体を有するプロセスカートリッジを備えた電子写真装置の概略構成を示す。

【0040】図11において、11はドラム状の本発明の電子写真感光体であり、軸12を中心に矢印方向に所定の周速度で回転駆動される。電子写真感光体11は、回転過程において、一次帯電手段13によりその周面に正又は負の所定電位の均一帯電を受け、次いで、スリット露光やレーザービーム走査露光等の露光手段(不図20示)から出力される目的の画像情報の時系列電気デジタル画像信号に対応して強調変調された露光光14を受ける。こうして電子写真感光体11の周面に対し、目的の画像情報に対応した静電潜像が順次形成されていく。

【0041】形成された静電潜像は、次いで現像手段15によりトナー現像され、不図示の給紙部から電子写真感光体11と転写手段16との間に電子写真感光体11の回転と同期して取り出されて給送された転写材17に、電子写真感光体11の表面に形成担持されているトナー画像が転写手段16により順次転写されていく。

[0042]トナー画像の転写を受けた転写材17は、電子写真感光体面から分離されて像定着手段18へ導入されて像定着を受けることにより画像形成物(プリント、コピー)として装置外へプリントアウトされる。 [0043] 像転写後の電子写真感光体11の表面は、

クリーニング手段19によって転写残りトナーの除去を 受けて清浄面化され、更に前露光手段(不図示)からの 前露光光20により除電処理された後、繰り返し画像形 成に使用される。なお、一次帯電手段13が帯電ローラ 一等を用いた接触帯電手段である場合は、前露光は必ず しも必要ではない。

【0044】本発明においては、上述の電子写真感光体 11、一次帯電手段13、現像手段15及びクリーニン グ手段19等の構成要素のうち、複数のものを容器に納 めてプロセスカートリッジとして一体に結合して構成 し、このプロセスカートリッジを複写機やレーザービー ムプリンター等の電子写真装置本体に対して着脱自在に 構成してもよい。例えば、一次帯電手段13、現像手段 15及びクリーニング手段19の少なくとも1つを電子 写真感光体11と共に一体に支持してカートリッジ化し て、装置本体のレール等の案内手段22を用いて装置本 体に着脱自在なプロセスカートリッジ21とすることが できる。

9

[0045]また、露光光14は、電子写真装置が複写機やプリンターである場合には、原稿からの反射光や透過光、あるいは、センサーで原稿を読取り、信号化し、との信号に従って行われるレーザービームの走査、LEDアレイの駆動又は液晶シャッターアレイの駆動等により照射される光である。

【0046】本発明の電子写真感光体は、電子写真複写機に利用するのみならず、レーザービームプリンター、CRTプリンター、LEDプリンター、FAX、液晶プリンター及びレーザー製版等の電子写真応用分野にも幅広く適用し得るものである。

[0047]

【実施例】以下、実施例及び比較例により本発明を更に 詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定 されるものではない。

[0048]以下に示す「%」及び「部」は、それぞれ「質量%」及び「質量部」を意味する。

[0049] (実施例1) o-フタロニトリル73g、三塩化ガリウム25g、α-クロロナフタレン400m 1を窒素雰囲気下200℃で6時間反応させた後、130℃で生成物をろ過した。得られた生成物をN、N-ジメチルホルムアミドを用いて130℃で1時間分散した、ろ過し、メタノールで洗浄後に乾燥し、クロロガリウムフタロシアニンを45g得た。

【0050】次いで、得られたクロロガリウムフタロシアニン15gを10℃の濃硫酸450gに溶解させ、氷水2300g中に攪拌下に滴下して再析出させて、ろ過した。2%アンモニア水で分散洗浄後、イオン交換水で十分洗浄、乾燥して低結晶性のヒドロキシガリウムフタロシアニンを13g得た。次に、得られたヒドロキシガリウムフタロシアニン7g、N、N-ジメチルホルムアミド210gを1mmφのガラスビーズ300gと共にサンドミルでミリング処理を室温(22℃)下で5時間行った。この分散液より固形分を取り出し、メタノールで十分に洗浄、乾燥し5.6gを得た。

【0051】更に、このヒドロキシガリウムフタロシア ニン結晶をN, N-ジメチルホルムアミド500ml中*

* で1時間加熱遠流を行った後、40℃で24時間真空乾燥することで本発明のヒドロキシガリウムフタロシアニン結晶を5.4g得た。得られた結晶の粉末X線回折図を図1に示す。

10

【0052】(実施例2)実施例1におけるN,N-ジメチルホルムアミド加熱還流処理を500m1N,N-ジメチルホルムアミド:イオン交換水(1:1)で100℃にて1時間攪拌処理にした以外は、実施例1と同様にして処理し、粉末X線回折図が図4に示す結晶形を得た。なお、用いたイオン交換水は電導度が0.1μS/cm、またpHが7.0のものを使用した。

【0053】(実施例3)実施例1におけるN, N-ジメチルホルムアミド加熱還流処理を室温で2度500m1N, N-ジメチルホルムアミド分散処理にした以外は、実施例1と同様にして処理し、粉末X線回折図が図5に示す結晶形を得た。

[0054] (実施例4)実施例1におけるN, N-ジメチルホルムアミド加熱還流処理をソックスレー抽出器による洗浄に代えた以外は、実施例1と同様にして処理 0、粉末X線回折図が図6に示す結晶形を得た。

【0055】(実施例5)実施例1における反応時間を 4時間にした以外は、実施例1と同様にして処理し、粉 末X線回折図が図7に示す結晶形を得た。

【0056】(比較例1)実施例5のN, N-ジメチルホルムアミド加熱還流処理をなくし40℃で真空乾燥した以外は、実施例5と同様にして処理し、粉末X線回折図が図8に示す結晶形を得た。

【0057】(比較例2)実施例1のN, N-ジメチルホルムアミド加熱還流処理をなくし40℃で真空乾燥しな以外は、実施例1と同様にして処理し、粉末X線回折図が図9に示す結晶形を得た。

【0058】得られた各サンプルの元素分析結果と25.9°ピークの半値幅を表1に示した。なお、比較例は、 $CuK\alpha$ 特性X線回折におけるブラッグ角($2\theta\pm0.2$ °)が26.2°のピークが25.9°のピークに重なっており、半値幅の測定はできなかった。

[0059]

【表1】

		表1		
1	С	Н	N	W
	(%)	(%)	(%)	(*)
計算値	64.14	2.86	18.70	
実施例 1	63.85	2.72	18.92	0.25
実施例 2	64.30	2.88	19.02	0.25
実施例 3	63.90	2.62	18.55	0.31
実施例 4	63.97	2.92	18.98	0.25
実施例 5	63.77	2.53	18.45	0.25
比較例 1	63.97	2.92	18.30	
比較例 2	63.88	3.01	18.81	

【0060】以下、本発明の結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニンを電子写真感光体に適用した例を示

す

50 【0061】(実施例6)10%の酸化アンチモンを含

有する酸化スズで被覆した酸化チタン粉体50部、レゾール型フェノール樹脂25部、メチルセロソルブ20部、メタノール5部及びシリコーンオイル(ポリジメチルシロキサン・ポリオキシアルキレン共重合体、平均分子量3000)0.002部を1mmφガラスピーズを用いたサンドミルで2時間分散して導電層用塗工液を調製した。アルミニウムシリンダー(φ30mm×260mm)上に、導電層用塗工液を浸漬塗布し、140°Cで30分間乾燥させ、膜厚が20μmの導電層を形成した。

11

【0062】次に、導電層上に6-66-610-12 四元系ポリアミド共重合体5部をメタノール70部/ブタノール25部を混合溶媒に溶解した溶液を浸漬塗布、乾燥して、膜厚1μmの下引き層を形成した。

【0063】次に、実施例1で製造した結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニン2部とポリビニルブチラール1部をシクロヘキサノン100部に添加し、1mmφガラスビーズを用いたサンドミルで1時間分散し、これに酢酸エチル100部を加えて希釈して電荷発生層用塗工液を調製した。下引き層上に、この電荷発生層用塗工 20液を浸漬塗布し、100℃で10分間乾燥して、膜厚が0.15μmの電荷発生層を形成した。

【0064】次に、下記構造式の電荷輸送材料10部 【0065】

【化2】

$$H_3C$$
 N
 C
 H_4C

【0066】とビスフェノールZ型ポリカーボネート10部をクロロベンゼン60部に溶解し、電荷輸送層用塗工液を調製した。電荷発生層上に電荷輸送層用塗工液を浸漬塗布し、110℃で1時間乾燥して、膜厚が20μmの電荷輸送層を形成した。とうして電子写真感光体を作製した。

【0067】(実施例7)実施例6において用いた電荷発生材料に代えて、実施例2で製造した結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用い

た以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製 した。

12

【0068】(実施例8)実施例6において用いた電荷 発生材料に代えて、実施例3で製造した結晶形のヒドロ キシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用い た以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製 した

【0069】(実施例9)実施例6において用いた電荷 発生材料に代えて、実施例4で製造した結晶形のヒドロ 10 キシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用い た以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製

【0070】(実施例10)実施例6において用いた電荷発生材料に代えて、実施例5で製造した結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用いた以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製した。

[0071] (比較例3) 実施例6において用いた電荷 発生材料に代えて、比較例1で製造した結晶形のヒドロ キシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用い た以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製 した

【0072】(比較例4)実施例6において用いた電荷発生材料に代えて、比較例2で製造した結晶形のヒドロキシガリウムフタロシアニンを電荷発生材料として用いた以外は、実施例6と同様にして電子写真感光体を作製した。

【0073】実施例6~10及び比較例3、4で作製し た電子写真感光体の評価法を以下に説明する。実験には 30 ヒューレットパッカード社製LBP「レーザージェット 4000」(プロセススピード94.2mm/sec) を用いて、測定は全て、25℃/相対湿度が50%とな る環境で評価を行い、電子写真感光体ドラムは、測定前 最低24時間は、測定環境に放置したものを用いた。と の状態でAC/DC帯電方式で負帯電を行い暗部電位 (Vd) を測定し、との状態に0.3 µJc m⁻²の光量 のレーザー光を照射し2周目以降の明部電位(VL)を 測定した。また、帯電後ドラム回転と負帯電を同時に止 め、18秒間放置した後の電位(Vdd)と暗部電位 (Vd) の比率 (%Vdd=Vdd/Vd)、ドラム回 転を止めることなく、帯電を止め同時に露光を行いドラ ム回転3周後の電位 (Vr)も同時に測定した。Vd、 VL、%Vdd、Vrの結果を表2に示す。

[0074]

【表2】

		表 2		
	Vd	VL	%Vdd	Vr
	600	153	0.87	35
実施例 7	600	152	0.90	35
実施例 8	600	155	0.89	25
実施例 9	600	152	0.89	25
実施例 10	600	155	0.88	30
比較例 3	600	175	0.93	40
比較例 4	600	185	0.89	50

[0075]

【発明の効果】上述してきたように、本発明のヒドロキ シガリウムフタロシアニンは、新規の結晶形を有するも 10 【符号の説明】 ので、このヒドロキシガリウムフタロシアニンを用いた 電子写真感光体は、長波長の光線に対してより高い感度 を示し、感度のバラツキが少なく、良好な電子写真特性 を提供することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のX線回折スペクトルを示す図であ

【図2】ショルダービークを持たないX線回折線の半値 幅の測定例を示す図である。

【図3】ショルダーピークを持つX線回折線の半値幅の 20 2 導電層 測定例を示す図である。

【図4】実施例2のX線回折スペクトルを示す図であ る。

【図5】実施例3のX線回折スペクトルを示す図であ

【図6】実施例4のX線回折スペクトルを示す図であ

【図7】実施例5のX線回折スペクトルを示す図であ

【図8】比較例1のX線回折スペクトルを示す図であ

【図9】比較例2のX線回折スペクトルを示す図であ

【図10】本発明の電子写真感光体の概略構成を示す図 である。

【図11】本発明の電子写真感光体を有するプロセスカ米

*ートリッジを備えた電子写真装置の概略構成の例を示す 図である。

A バックグランド

B 接線

垂線

D 中線

₩ 半値幅

Χ ピークの頂点

Y 接点

Z 中点

支持体 1

下引き層

4 電荷発生層

5 電荷輸送層

11 電子写真感光体

12 軸

13 帯電手段

14 露光光

15 現像手段

16 転写手段

30 17 転写材

18 定着手段

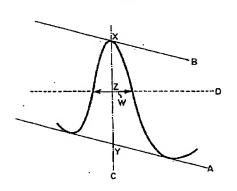
19 クリーニング手段

20 前露光光

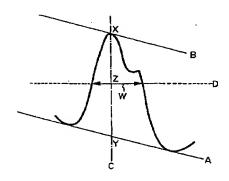
21 プロセスカートリッジ

22 案内手段

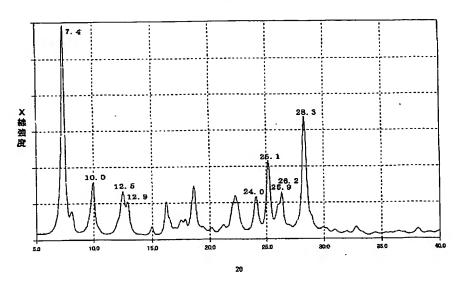
【図2】



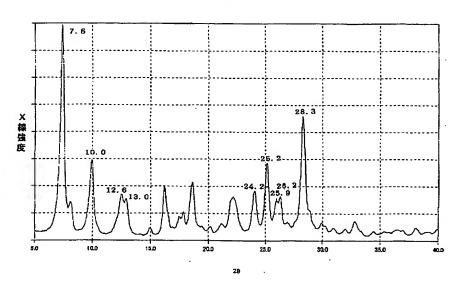
【図3】



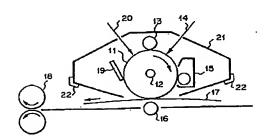
【図1】



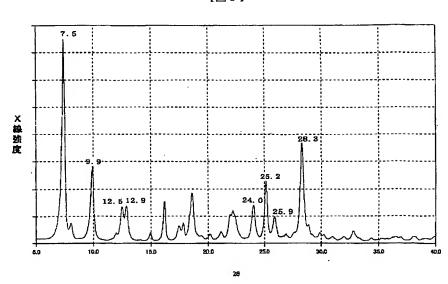
【図4】



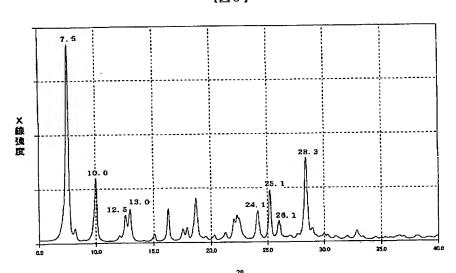
[図11]



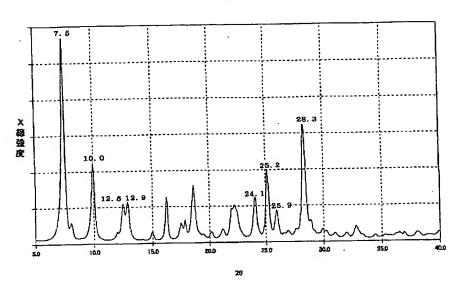
【図5】



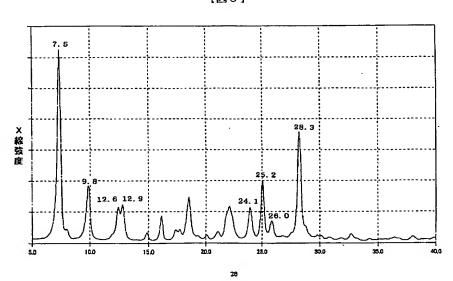
【図6】



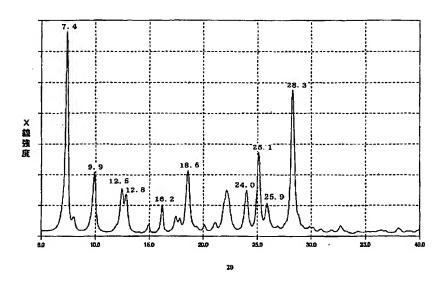
【図7】



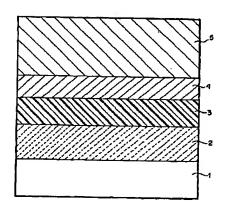
[図8]







【図10】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	
--------------	--

識別記号

FI

テーマコード(参考)

C 0 9 B 67/16

G 0 3 G 5/06

371

C 0 9 B 67/16 G 0 3 G 5/06

371

(72)発明者 平野 秀敏

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 藤井 淳史

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内 (72)発明者 浜 一江

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ ノン株式会社内

Fターム(参考) 2H068 AA19 AA37 BA39 EA04 FA27 4C050 PA14